



THE PATENT OFFICE OF THE STATE INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE
OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Address: No. 6 Xi Tucheng Lu, Jimeng Qiao Haidian District, Beijing Post code: 100088 P.O. BOX: Beijing 8020

Shanghai Patent & Trademark Law Office

Date of Dispatch
February 9, 2007

Application No.: 200480003252.4	Applicant: SEMICONDUCTOR ENERGY LABORATORY CO., LTD.
Application Date: January 30, 2004	Agent:
Title: METHOD FOR MANUFACTURING DISPLAY	

THE FIRST OFFICE ACTION
(PCT APPLICATION IN THE NATIONAL PHASE)

- ☒ According to the Request for Substantive Examination raised by the applicant and based on the provision of Item 1, Article 35 of the Patent Law, the Examiner has proceeded with the Examination as to Substance on the above mentioned application for patent for invention.
☐ According to Item 2, Article 35 of the Chinese Patent Law, the Patent Office has decided to examine the above application for patent for invention.
- ☒ The applicant has requested that the filling date of
Feb 5, 2003 at the JP Patent Office as the priority date,
Feb 5, 2003 at the JP Patent Office as the priority date,
_____ at the _____ Patent Office as the priority date,
- ☐ The following amended documents submitted by the applicant cannot be accepted for not conforming to the provision of Article 33 of the Patent Law:
☐ The Chinese version of the attachment of the International Preliminary Examination Report.
☐ The Chinese version of the amended document submitted according to the provision of Rule 19 of the Patent Cooperation Treaty.
☐ The amended document submitted according to the provision of Rule 28 or Rule 41 of the Patent Cooperation Treaty.
☐ The amended document submitted according to the provision of Rule 51 of the Implementing Regulations of the Patent Law.
Refer to the text of the notice for the specific reason of non-acceptance thereof.
- ☒ The examination is conducted by directing at the Chinese version of the original International Application submitted.
☐ The examination is conducted by directing at the following application documents:
☐ **Description,**
p. _____, the Chinese version of the original International Application Document submitted;
p. _____, the Chinese version of the attachment of the International Preliminary Examination Report;
p. _____, the amended document submitted according to the provision of Rule 28 or Rule 41 of the Patent Cooperation Treaty.

p. _____, the amended document submitted according to the provision of Rule 51 of the Implementing Regulations of the Patent Law.

☐ **Claims,**

_____, the Chinese version of the original International Application Document submitted.

_____, the Chinese version of the amended document submitted according to the provision of Rule 19 of the Patent Cooperation Treaty.

_____, the Chinese version of the attachment of the International Preliminary Report.

_____, the amended document submitted according to the provision of Rule 28 or Rule 41 of the Patent Cooperation Treaty.

_____, the amended document submitted according to the provision of Rule 51 of the Implementing Regulations of the Patent Law.

☐ **Attached Drawings,**

p. _____, the Chinese version of the original International Application Document submitted.

p. _____, the Chinese version of the attachment of the International Preliminary Examination Report.

p. _____, the amended document submitted according to the provision of Rule 28 or Rule 41 of the Patent Cooperation Treaty.

p. _____, the amended document submitted according to the provision of Rule 51 of the Implementing Regulations of the Patent Law.

5. ☒ This Notice cites the following Comparison Document(the number of which shall continue to be used in the subsequent examination proceedings):

No.	Number/Title of Document	Date of Publication (or the filing date of the conflicting Application)
1	JP2002-237480A	2002.08.23
2	JP2000-328269A	2000.11.28
3	JP11-340129A	1999.12.10
4	JP2000-289864A	2002.10.01

6. The conclusive opinion drawn from the examination:

☐ **As regards the Specification:**

☐ The contents of the application fall under the scope stipulated by Article 5 of the Patent Law for which no patent right should be granted.

☐ The specification does not conform with the provision of Item 3, Article 26 of the Patent Law.

☐ The drafting of the specification does not conform with the provision of Rule 18 of the Implementing Regulations.

☒ **As regards the Claims:**

☐ Claim _____ does not possess the novelty as stipulated in Item 2, Article 22 of the Patent Law.

☒ Claim 1-11 does not possess the inventiveness as stipulated in Item 3, Article 22 of the Patent Law.

☐ Claim _____ does not possess the practical applicability as stipulated in Item 4, Article 22 of the Patent Law.

☐ Claim _____ falls under the scope of Article 25 of the Patent Law where no patent right is to be granted.

☐ Claim _____ does not conform with the provision of Item 4, Article 26 of the Patent Law.

- ☐ Claim _____ does not conform with the provision of Item 1, Article 31 of the Patent Law.
- ☐ Claim _____ does not conform with the provision of Item 1, Rule 13 of the Implementing Regulations of the Patent Law.
- ☐ Claim _____ does not conform with the provision of Rule 18 of the Implementing Regulations of the Patent Law.
- ☐ Claim _____ does not conform with the provisions of Rules 20 of the Implementing Regulations of the Patent Law.
- ☐ Claim _____ does not conform with the provisions of Rules 21 of the Implementing Regulations of the Patent Law.
- ☐ Claim _____ does not conform with the provisions of Rules 22 of the Implementing Regulations of the Patent Law.
- ☐ Claim _____ does not conform with the provisions of Rules 23 of the Implementing Regulations of the Patent Law.

Refer to the text of this Notice for the specific analyses of the conclusive opinion.

7. Based on the above conclusive opinion, the Examiner deems that:

- ☐ The applicant shall amend the application documents in accordance with the requirements raised in the text of the Notice.
- ☐ The applicant shall discuss in his observations reasons why this application for patent can be granted a patent right, and amend the portions indicated in the text of the Notice which have been deemed as not conforming with the provisions, or no patent right shall be granted.
- ☒ There are no substantive contents in the application for patent that can be granted a patent right. If the applicant does not present reasons or the reasons presented are not sufficient, the application shall be rejected.

8. The applicant is asked to note the following items:

- (1) According to the provision of Article 37 of the Patent Law, the applicant shall submit his observations within **four months** from the receipt of this Notice. Where, without justified reasons, the applicant does not respond at the expiration of said date, the application shall be deemed to have been withdrawn.
- (2) The applicant shall amend his application according to Article 33 of the Patent Law. The amended documents shall be in duplicate, and the form, in conformity with the relevant provisions in the Examination Guide.
- (3) The applicant and/or his agent can not, without first making an appointment, go to the Patent Office to have an interview with the Examiner.
- (4) The observations and/or the amended documents shall be mailed or delivered to the Department of Receipt, the Patent Office of the State Intellectual Property Office. No documents shall possess legal effects if not mailed or delivered to the Department of Receipt.

9. The text of this Notice totals 7 page(s), and includes the following attachment(s):



- ☒ duplicate copy(ies) of cited comparison document(s), altogether 4 copy(ies) 34 pages.

Examination Department: _____ Examiner(Seal):

054768 1PWCN
PCT/171



中华人民共和国国家知识产权局

200233	上海桂平路 435 号 上海专利商标事务所有限公司 沈昭坤	发文日 
申请号: 2004800032524		
申请人: 株式会社半导体能源研究所		
发明名称: 显示装置的制造方法		

第一次审查意见通知书

(进入国家阶段的 PCT 申请)

- ☒ 应申请人提出的实审请求, 根据专利法第 35 条第 1 款的规定, 国家知识产权局对上述发明专利申请进行实质审查。
☐ 根据专利法第 35 条第 2 款的规定, 国家知识产权局专利局决定自行对上述发明专利申请进行审查。
- ☒ 申请人要求以其在:
JP 专利局的申请日 2003 年 02 月 05 日为优先权日,
JP 专利局的申请日 2003 年 02 月 05 日为优先权日,
专利局的申请日 年 月 日为优先权日。
- ☐ 申请人于 年 月 日和 年 月 日以及 年 月 日提交了修改文件。
经审查, 申请人于 年 月 日提交的 不符合专利法实施细则第 51 条第 1 款的规定。
☐
- ☒ 审查是针对原始提交的国际申请的中文译文进行的。
☐ 审查是针对下述申请文件进行的:
☐ 说明书 第 页, 按照进入中国国家阶段时提交的国际申请文件的中文文本;
第 页, 按照专利性国际初步报告附件的中文文本;
第 页, 按照依据专利合作条约第 28 条或 41 条规定所提交的修改文件;
第 页, 按照依据专利法实施细则第 51 条第 1 款规定所提交的修改文件;
第 页, 按照 年 月 日所提交的修改文件。
☐
☐ 权利要求 第 项, 按照进入中国国家阶段时提交的国际申请文件的中文文本;
第 项, 按照依据专利合作条约第 19 条规定所提交的修改文件的中文文本;
第 项, 按照专利性国际初步报告附件的中文文本;
第 项, 按照依据专利合作条约第 28 条或 41 条规定所提交的修改文件;
第 项, 按照依据专利法实施细则第 51 条第 1 款规定所提交的修改文件;
第 页, 按照 年 月 日所提交的修改文件。
☐
☐ 附图 第 页, 按照进入中国国家阶段时提交的国际申请文件的中文文本;
第 页, 按照专利性国际初步报告附件的中文文本;
第 页, 按照依据专利合作条约第 28 条或 41 条规定所提交的修改文件;
第 页, 按照依据专利法实施细则第 51 条第 1 款规定所提交的修改文件;
第 页, 按照 年 月 日所提交的修改文件。



☐

☒ 本通知书引用下述对比文件(其编号在今后的审查过程中继续沿用):

编号	文件号或名称	公开日期 (或抵触申请的申请日)
1	JP2002-237480A	2002-8-23
2	JP2000-328269A	2000-11-28
3	JP11-340129A	1999-12-10
4	JP2000-289864A	2002-10-4

5. 审查的结论性意见:

☐ 关于说明书:

- ☐ 申请的内容属于专利法第 5 条规定的不授予专利权的范围。
- ☐ 说明书不符合专利法第 26 条第 3 款的规定。
- ☐ 说明书不符合专利法第 33 条的规定。
- ☐ 说明书的撰写不符合专利法实施细则第 18 条的规定。

☒ 关于权利要求书:

- ☐ 权利要求 不具备专利法第 22 条第 2 款规定的新颖性。
- ☒ 权利要求 1-11 不具备专利法第 22 条第 3 款规定的创造性。
- ☐ 权利要求 不具备专利法第 22 条第 4 款规定的实用性。
- ☐ 权利要求 属于专利法第 25 条规定的不授予专利权的范围。
- ☐ 权利要求 不符合专利法第 26 条第 4 款的规定。
- ☐ 权利要求 不符合专利法第 31 条第 1 款的规定。
- ☐ 权利要求 不符合专利法第 33 条的规定。
- ☐ 权利要求 不符合专利法实施细则第 2 条第 1 款的规定。
- ☐ 权利要求 不符合专利法实施细则第 13 条第 1 款的规定。
- ☐ 权利要求 不符合专利法实施细则第 20 条的规定。
- ☐ 权利要求 不符合专利法实施细则第 21 条的规定。
- ☐ 权利要求 不符合专利法实施细则第 22 条的规定。
- ☐ 权利要求 不符合专利法实施细则第 23 条的规定。

☐ 分案的申请不符合专利法实施细则第 43 条第 1 款的规定。

上述结论性意见的具体分析见本通知书的正文部分。

6. 基于上述结论性意见, 审查员认为:

- ☐ 申请人应按照通知书正文部分提出的要求, 对申请文件进行修改。
- ☐ 申请人应在意见陈述书中论述其专利申请可以被授予专利权的理由, 并对通知书正文部分中指出的不符合规定之处进行修改, 否则将不能授予专利权。
- ☒ 专利申请中没有可以被授予专利权的实质性内容, 如果申请人没有陈述理由或者陈述理由不充分, 其申请将被驳回。

7. 申请人应注意下述事项:

- (1) 根据专利法第 37 条的规定, 申请人应在收到本通知书之日起的肆个月内陈述意见, 如果申请人无正当理由逾期不答复, 其申请将被视为撤回。
- (2) 申请人对其申请的修改应符合专利法第 33 条的规定, 修改文本应一式两份, 其格式应符合审查指南的有关规定。
- (3) 申请人的意见陈述书和 / 或修改文本应邮寄或递交国家知识产权局专利局受理处, 凡未邮寄或递交给受理处的文件不具备法律效力。
- (4) 未经预约, 申请人和 / 或代理人不得前来国家知识产权局专利局与审查员举行会晤。

8. 本通知书正文部分共有 7 页, 并附有下列附件:

☒ 引用的对比文件的复印件共 4 份 34 页。

☐

审查员: 王文杰 (A165)

2007 年 1 月 21 日



审查部门

电学发明审查部

21302
2006. 7



回函请寄: 100088 北京市海淀区蓟门桥西土城路 6 号 国家知识产权局专利局受理处收
(注: 凡寄给审查员个人的信函不具有法律效力)



第一次审查意见通知书正文

申请号：2004800032524

本申请涉及一种显示装置的制造方法。经审查，现提出如下的审查意见。

1、权利要求 1 所要求保护的技术方案不具备专利法第二十二条第三款规定的创造性。对比文件1 (JP2002-237480A) 公开了一种用等离子体处理基板材料的方法，并具体公开了以下技术特征“在大气压或接近大气压条件下，用带有一对相对电极的等离子体处理装置，得到等离子体，使等离子体与基板接触、处理基板，等离子体装置的喷嘴在基板表面移动，在基板表面局部形成薄膜，如SiN膜、SiO₂膜、金属硅化物膜、透明导电膜、聚合物膜等，对薄膜进行处理形成配线等，也可以用卤素系气体进行刻蚀处理、切割处理，用氧系气体进行抗蚀层或保护层处理，也可以固定等离子处理装置、用传送带移动基板对基板进行处理”（参见该对比文件的权利要求 1, 13、说明书第4栏第37~41行，第6栏第14~50行，第7栏第1~8行，第14栏第33~49行、图3~图10）。该权利要求所要求保护的技术方案与该对比文件所公开的内容相比，区别技术特征为工艺在“5~800torr的压力下”进行，要解决的技术问题是节省抽真空的时间并节省真空系统等设备。然而5~800torr作为接近大气压的压力，是本领域的公知常识。在对比文件1的基础上结合上述公知常识以获得该权利要求所要保护的技术方案，对所属技术领域的技术人员来说是显而易见的，因此该权利要求不具有突出的实质性特点和显著的进步，不具有专利法第二十二条第三款规定的创造性。

2、权利要求 2 所要求保护的技术方案不具备专利法第二十二条第三款规定的创造性。对比文件 1 (JP2002-237480A) 公开了一种用等离子体处理基板材料的方法，并具体公开了以下技术特征“在大气压或接近大气压条件下，用带有一对相对电极的等离子体处理装置，得到等离子体，使等离子体与基板接触、处理基板，等离子体装置的喷嘴在基板表面移动，在基板表面局部形成薄膜，如SiN膜、SiO₂膜、金属硅化物膜、透明导电膜、聚合物膜等，对薄膜进行处理形成配线等，也可以用卤

素系气体进行刻蚀处理、切割处理，用氧系气体进行抗蚀层或保护层处理，也可以固定等离子处理装置、用传送带移动基板对基板进行处理”（参见该对比文件的权利要求1，13、说明书第4栏第37～41行，第6栏第14～50行，第7栏第1～8行，第14栏第33～49行、图3～图10）。该权利要求所要求保护的技术方案与该对比文件所公开的技术内容相比，其区别技术特征在于：（1）工艺在“5～800torr的压力下”进行；（2）“等离子体处理单元的发生等离子体用的电极是多个”。区别特征（1）5～800torr作为接近大气压的压力，是本领域的公知常识；区别特征（2）已被对比文件2（JP2000-328269A）公开（参见对比文件2的说明书第3栏第28～34行、图1，图2），该区别特征从权利要求2的表述来看，在对比文件2中所起的作用与其在本发明中为解决其技术问题所起的作用相同，都是用于激发等离子体，也就是说对比文件2给出了将该技术特征用于对比文件1以解决其技术问题的启示。由此可知，在对比文件1的基础上结合对比文件2以及本领域的公知常识，得出权利要求2所要求保护的技术方案，对本领域的技术人员来说是显而易见的，不具有突出的实质性特点和显著的进步，因此该权利要求不具备创造性。

3、权利要求3不具备专利法第二十二条第三款规定的创造性。对比文件1（JP2002-237480A）公开了一种用等离子体处理基板材料的方法，并具体公开了以下技术特征“在大气压或接近大气压条件下，用带有一对相对电极的等离子体处理装置，得到等离子体，使等离子体与基板接触、处理基板，等离子体装置的喷嘴在基板表面移动，在基板表面局部形成薄膜，如SiN膜、SiO₂膜、金属硅化物膜、透明导电膜、聚合物膜等，对薄膜进行处理形成配线等，也可以用卤素系气体进行刻蚀处理、切割处理，用氧系气体进行抗蚀层或保护层处理，也可以固定等离子处理装置、用传送带移动基板对基板进行处理”（参见该对比文件的权利要求1，13、说明书第4栏第37～41行，第6栏第14～50行，第7栏第1～8行，第14栏第33～49行、图3～图10）。该权利要求与对比文件1的区别在于：（1）工艺过程是基板上先形成导电膜，在所述导电膜上形成抗蚀剂掩模，接着以抗蚀剂掩模作为掩模、对导电膜进行蚀刻以形成配线；（2）基板上形成导电膜、对导电膜进行蚀刻都是在“5～800torr的压力下”进行。作为区别特征（1）的工艺过程，对于本领域技术人员来说，属于公知常识；

区别特征2的“5~800torr”作为接近大气压的压力，是本领域的公知常识。在对比文件1的基础上结合上述公知常识以获得权利要求3所要求保护的技术方案，对所属技术领域的技术人员来说是显而易见的，不具备突出的实质性特点和显著的进步，因此该权利要求不具备创造性。

4、权利要求4所要求保护的技术方案不具备专利法第二十二条第三款规定的创造性。对比文件1（JP2002-237480A）公开了一种用等离子体处理基板材料的方法，并具体公开了以下技术特征“在大气压或接近大气压条件下，用带有一对相对电极的等离子体处理装置，得到等离子体，使等离子体与基板接触、处理基板，等离子体装置的喷嘴在基板表面移动，在基板表面局部形成薄膜，如SiN膜、SiO₂膜、金属硅化物膜、透明导电膜、聚合物膜等，对薄膜进行处理形成配线等，也可以用卤素系气体进行刻蚀处理、切割处理，用氧系气体进行抗蚀层或保护层处理，也可以固定等离子处理装置、用传送带移动基板对基板进行处理”（参见该对比文件的权利要求1、13、说明书第4栏第37~41行，第6栏第14~50行，第7栏第1~8行，第14栏第33~49行、图3~图10）。权利要求4所要求保护的技术方案与对比文件1所公开的技术内容相比，其区别特征在于（1）“第1等离子体处理单元的发生等离子体用的电极是多个”；（2）显示装置的一种制造方法的工序包括“基板上先形成导电膜，再在导电膜上形成抗蚀剂掩模，接着以抗蚀剂掩模作为掩模、对导电膜进行刻蚀以形成配线”；（3）基板上形成导电膜，对导电膜进行蚀刻都是在“5~800torr的压力下”进行。这些区别特征中，区别特征（1）已被对比文件2（JP2000-328269A）公开（参见对比文件2的说明书第3栏第28~34行、图1，图2），在对比文件2中所起的作用与其在本发明中为解决其技术问题所起的作用相同，都是用于激发等离子体，也就是说对比文件2给出了将该技术特征用于对比文件1以解决其技术问题的启示。而特征（2）、（3）是本领域的公知常识。由此可知，在对比文件1的基础上结合对比文件2以及本领域的公知常识，得出权利要求4的技术方案，对本技术领域的技术人员来说是显而易见的，不具有突出的实质性特点和显著的进步，因此该权利要求不具备创造性。

5、权利要求 5 (JP2002-237480A) 所要求保护的技术方案不具备专利法第二十二条第三款规定的创造性。对比文件 1 公开了一种用等离子体处理基板材料的方法,并具体公开了以下技术特征“在大气压或接近大气压条件下,用带有一对相对电极的等离子体处理装置,得到等离子体,使等离子体与基板接触、处理基板,等离子体装置的喷嘴在基板表面移动,在基板表面局部形成薄膜,如SiN膜、SiO₂膜、金属硅化物膜、透明导电膜、聚合物膜等,对薄膜进行处理形成配线等,也可以用卤素系气体进行刻蚀处理、切割处理,用氧系气体进行抗蚀层或保护层处理,也可以用固定等离子处理装置、用传送带移动基板对基板进行处理”(参见该对比文件的权利要求1, 13、说明书第4栏第37~41行,第6栏第14~50行,第7栏第1~8行,第14栏第33~49行、图3~图10)。该权利要求所要求保护的技术方案与该对比文件所公开的技术内容相比,其区别特征在于(1) “第2等离子体处理单元的发生等离子体用的电极是多个”;(2) 显示装置的一种制造方法的工序包括“基板上先形成导电膜,再在导电膜上形成抗蚀剂掩模,接着以抗蚀剂掩模作为掩模、对导电膜进行刻蚀以形成配线”;(3) 基板上形成导电膜,对导电膜进行蚀刻都是在“5~800torr的压力下”进行。这些区别特征中,区别特征(1)已被对比文件2(JP2000-328269A)公开(参见对比文件2的说明书第3栏第28~34行、图1,图2),在对比文件2中所起的作用与其在本发明中为解决其技术问题所起的作用相同,都是用于激发等离子体,也就是说对比文件2给出了将该技术特征用于对比文件1以解决其技术问题的启示。而特征(2)、(3)是本领域的公知常识。由此可知,在对比文件1的基础上结合对比文件2以及本领域的公知常识,得出该权利要求的技术方案,对本技术领域的技术人员来说是显而易见的,不具有突出的实质性特点和显著的进步,因此该权利要求不具备创造性。

6、权利要求 6 是权利要求 1~5 的从属权利要求,权利要求6择一引用权利要求1~5,其附加技术特征为“基板为1000×1200mm² 以上大小的基板”,但这个特征是所属技术领域中的公知常识,用于第五代液晶屏的玻璃基板的尺寸一般为1000×1200mm²。当权利要求6引用权利要求1或3时,在对比文件1的基础上结合公知常识获得权利要求6要求保护的技术方案,对本领域的技术人员来说是显而易见的,不

具有突出的实质性特点和显著的进步，该从属权利要求不具备专利法第二十二条第三款规定的创造性；当权利要求6择一引用权利要求2、4、5时，在对比文件1的基础上结合对比文件2以及公知常识获得权利要求要求保护的技术方案，对本领域的技术人员来说是显而易见的，不具有突出的实质性特点和显著的进步，该从属权利要求也不具备专利法第二十二条第三款规定的创造性。

7、权利要求 7 是权利要求 1~5 的从属权利要求，权利要求7择一引用权利要求1~5，其附加技术特征“等离子体处理单元在一个方向上对所述基板上进行扫描”也已在对比文件 1 中相应地公开（参见对比文件 1（JP2002-237480A）的说明书第12栏第22~23行，说明书第13栏第3~4行，说明书第12栏第34~36行），且其在对比文件1中所起的作用与其在本发明中所起的作用相同，都是用于等离子体处理装置在被处理物体上作扫描；当权利要求7择一引用权利要求1~5时，在权利要求1~5不具备创造性的情况下，该从属权利要求也不具有突出的实质性特点和显著的进步，不具备专利法第二十二条第三款规定的创造性。

8、权利要求 8 是权利要求 1~5 的从属权利要求，权利要求8择一引用权利要求1~5，其附加技术特征“等离子体处理单元在行方向和列方向上交替对所述基板上进行扫描”也已在对比文件 1（JP2002-237480A）中相应地公开（参见对比文件 1 的说明书第12栏第22~23行，说明书第13栏第3~4行，说明书第12栏第34~36行），且其在对比文件1中所起的作用与其在本发明中所起的作用相同，都是用于等离子体处理装置在被处理物体上可作x-y-z扫描；当权利要求8择一引用权利要求1~5时，在权利要求1~5不具备创造性的情况下，该从属权利要求也不具有突出的实质性特点和显著的进步，不具备专利法第二十二条第三款规定的创造性。

9、从属权利要求 9 是权利要求 3~5 的从属权利要求，权利要求9择一引用权利要求3~5，其附加技术特征为“使用液滴喷出单元形成所述抗蚀剂掩模”，此特征已在对比文件3（JP11-340129A）中相应地公开（参见该对比文件的说明书第7页右栏第4~7行、图4），且其在对比文件 3 中所起的作用与其在本发明中所起的作用

相同,都是用于抗蚀剂掩模的形成,即对比文件3给出了将上述附加技术特征应用到对比文件1以解决其技术问题的启示。当权利要求9引用权利要求3时,可知在对比文件1的基础上结合对比文件3以及公知常识得出该权利要求进一步限定的技术方案,对本领域的技术人员来说是显而易见的,该从属权利要求所要求保护的技术方案不具有突出的实质性特点和显著的进步,不具备专利法第二十二条第三款规定的创造性。当权利要求9引用权利要求4或5时,在对比文件1的基础上结合对比文件2、对比文件3以及本领域的公知常识,得出该权利要求要求保护的技术方案,对本领域的技术人员来说是显而易见的,不具有突出的实质性特点和显著的进步,因此该权利要求不具备创造性。

10、权利要求10不具备专利法第二十二条第三款规定的创造性。对比文件4(JP2002-289864A)公开了一种液晶显示器的薄膜晶体管的制造方法,并具体公开了以下技术特征“在半导体层上用PECVD形成有氧硅化物的栅极介电层(绝缘层),通过光刻、形成抗蚀剂掩模,用含有氟和氧的气体做为等离子刻蚀气体,以抗蚀剂掩模为掩模介电层的方法在介电层上形成开口”(参见对比文件4的说明书第2页右栏第45~49行,第4页右栏第41~50行,第5页左栏第1~31行、图1,图2,图4,图5);该权利要求与对比文件4的区别技术特征在于:在绝缘膜喷反应气体形成开口部的工序是局部地对绝缘膜喷反应气体,该区别特征已被对比文件1(JP2002-237480A)公开(参见对比文件1的权利要求13、第7栏第1~8行,第14栏第33~49行、图3~图10),而且该特征在对比文件1中所起的作用与其在本发明中为解决其技术问题所起的作用相同,都是用于减少刻蚀工序中的反应气体使用量,也就是说对比文件1给出了将该技术特征用于对比文件4以解决其技术问题的启示。由此可知,在对比文件4的基础上结合对比文件1得出权利要求10所要求保护的技术方案,对本领域的技术人员来说是显而易见的,不具有突出的实质性特点和显著的进步,因此该权利要求所要求保护的技术方案不具备创造性。

11、权利要求11不具备专利法第二十二条第三款规定的创造性。对比文件4(JP2002-289864A)公开了一种液晶显示器的薄膜晶体管的制造方法,并具体公开

了以下技术特征“在半导体层上用PECVD形成有氧硅化物的栅极介电层（绝缘层），通过光刻、形成抗蚀剂掩模，用含有氟和氧的气体做为等离子刻蚀气体，以抗蚀剂掩模为掩模介电层的方法在介电层上形成开口”（参见对比文件4的说明书第2页右栏第45～49行，第4页右栏第41～50行，第5页左栏第1～31行、图1，图2，图4，图5）；该权利要求与对比文件4的区别技术特征在于：（1）形成抗蚀剂掩模是使用液滴喷出单元局部形成，（2）绝缘膜的蚀刻是在5～800torr的压力下使用等离子体处理单元进行。区别特征（1）已被对比文件3公开（参见对比文件3的说明书第7页右栏第4～7行、图4），而且该特征在对比文件3中所起的作用与其在本发明中为解决其技术问题所起的作用相同，都是用于抗蚀剂掩模的形成，也就是说对比文件3给出了将该技术特征用于该对比文件4以解决其技术问题的启示；对比文件1（JP2002-237480A）公开了绝缘膜的蚀刻是在大气压或接近大气压的条件下进行（参见对比文件1的权利要求1，13、说明书第4栏第37～41行，第6栏第14～50行，第7栏第1～8行，第14栏第33～49行、图3～图10），而“5～800torr”的压力认为是接近大气压的压力属于公知常识，因此区别特征（2）也被公开，而且该特征在对比文件1中所起的作用与其在本发明中为解决其技术问题所起的作用相同，都是用于在大气压或接近于大气压下的等离子体刻蚀处理，也就是说对比文件1结合公知常识给出了将该技术特征用于该对比文件4以解决其技术问题的启示。由此可知，在对比文件4的基础上结合对比文件3和对比文件1以及公知常识得出该权利要求所要求保护的技术方案，对本领域的技术人员来说是显而易见的，不具有突出的实质性特点和显著的进步，因此该权利要求不具备创造性。

基于上述理由，本申请的独立权利要求以及从属权利要求都不具备创造性，同时说明书中也没有记载其他任何可以授予专利权的实质性内容，因而即使申请人对权利要求进行重新组合和/或根据说明书记载的内容作进一步的限定，本申请也不具备被授予专利权的前景。如果申请人不能在本通知书规定的答复期限内提出表明本申请具有创造性的充分理由，本申请将被驳回。

审查员：王文杰

代码：A165